

ICF与激光等离子体

深振幅A1调制靶的化学腐蚀制备工艺研究

孙骥 周斌 杨帆 沈军 吴广明

(同济大学 波耳固体物理研究所, 上海 200092)

摘要: 介绍了用于惯性约束聚变分解实验的铝调制靶的制备。以半导体光刻工艺结合化学腐蚀工艺在铝箔表面引入周期为50 μm 的条槽图形, 研究腐蚀条件对腐蚀速率的影响; 采用光学显微镜、扫描电镜和台阶仪对图形形貌和样品表面成分进行测量和分析, 获得厚度在32 μm 左右、腐蚀深度达到20 μm 的铝调制靶。

关键词: [惯性约束聚变](#) [铝调制靶](#) [化学腐蚀](#)

通信作者:

相关文章([惯性约束聚变](#)):

[用序列二次规划法设计ICF靶区光路](#)

[ICF低温冷冻靶制备技术进展](#)

[微封装法制备聚苯乙烯空心微球的改进](#)

[测量软X射线脉冲信号的门控积分器](#)

[双电子复合过程在激光在Au靶耦合物理中的作用](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)